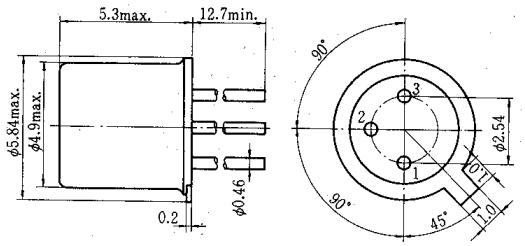
2SC2267Ⓗ

シリコン NPN 三重拡散形
高電圧スイッチング用
2SA1024Ⓗ とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE SWITCHING
Complementary pair with 2SA1024Ⓗ



1. エミッタ：Emitter
2. ベース：Base
3. コレクタ：Collector
   （ケース）（Case）

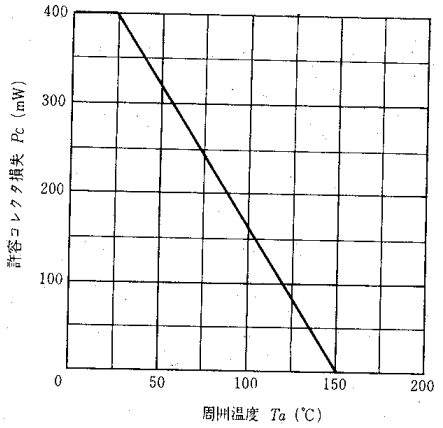
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SC2267Ⓗ	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	400	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	360	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	500	mA
許容コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=10μA, I_E=0	400	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=1mA, R_{BE}=∞	360	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=10μA, I_C=0	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	V_{CE}=250V, R_{BE}=∞	—	—	1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=20V, I_C=20mA	35	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=10mA, I_B=1mA	—	0.2	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=10mA, I_B=1mA	—	—	1.3	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=10V, I_C=10mA	40	70	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz	—	4.0	10	pF